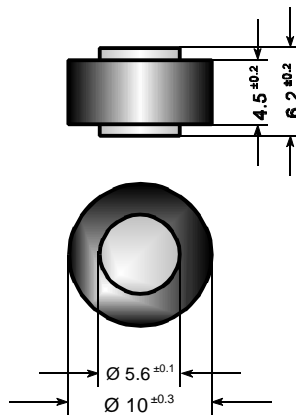


**Silicon Rectifier Button-Cells**
**Si-Gleichrichterzellen in Button-Bauform**


Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom 25 A

 Repetitive peak reverse voltage 50...1000 V  
 Periodische Spitzensperrspannung

 Plastic case, Ø 10 x 6.2 [mm]  
 coloured metal ring indicates cathode  
 Kunststoffgehäuse,  
 Kathode am farbig markierten Metallring

Weight approx. – Gewicht ca. 1.9 g

 Plastic material has UL classification 94V-0  
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

 Standard packaging: bulk  
 Standard Lieferform: Schüttgut

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspanng. $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
RA 2505	50	80
RA 251	100	130
RA 252	200	250
RA 253	300	350
RA 254	400	450
RA 255	500	550
RA 256	600	650
RA 258	800	850
RA 2510	1000	1050

 Max. average forward rectified current, R-load  $T_T = 100^\circ\text{C}$   $I_{FAV}$  25 A <sup>1)</sup>  
 Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last

 Repetitive peak forward current  $f > 15$  Hz  $I_{FRM}$  60 A <sup>1)</sup>  
 Periodischer Spitzenstrom

 Rating for fusing,  $t < 10$  ms  $T_A = 25^\circ\text{C}$   $i^2t$  1250 A<sup>2</sup>s  
 Grenzlastintegral,  $t < 10$  ms

<sup>1)</sup> Valid, if the temperature of the terminals is kept to 100°C  
 Gültig, wenn die Temperatur der Kontaktflächen auf 100°C gehalten wird

Peak forward surge current, single half sine-wave, superimposed on rated load Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{\text{FSM}}$	500 A
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	- 50...+175°C

**Characteristics****Kennwerte**

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 25\text{ A}$	$V_F$	< 0.95 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$	$I_R$	< 10 $\mu\text{A}$